

特許協力条約

PCT

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第 40、41 条)

[PCT 18 条、PCT 規則 43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A495	今後の手続きについては、様式 PCT/ISA/220 及び下記 5 を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2005/011331	国際出願日 (日.月.年) 21.06.2005	優先日 (日.月.年) 23.06.2004
出願人 (氏名又は名称) 日本電気株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第 41 条 (PCT 18 条) の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った (PCT 規則 23.1(b))。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる (第 I 欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 II 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 III 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第 IV 欄に示されているように、法施行規則第 47 条 (PCT 規則 38.2(b)) の規定により
国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこ
の国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 3 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているので、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/8238, 21/28, 27/092, 29/423, 29/49, 29/78

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/8238, 21/28, 27/092, 29/423, 29/49, 29/78

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

IEEE
JOIS Easy

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP 2003-258121 A (株式会社東芝) 2003.09.12, 全文 & US 2003/143825 A1	1-8 9-31
A	JP 2004-152995 A (株式会社東芝) 2004.05.27, 全文 & US 6727129 B1 & CN 1499612 A & KR 2004/038772 A	1-31

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

08.09.2005

国際調査報告の発送日

27.9.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

恩田 春香

4L

8934

電話番号 03-3581-1101 内線 3498

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2004-158593 A (株式会社東芝) 2004. 06. 03 & US 2004/084734 A1 & CN 1499635 A	1-31
A	MasZara et. al. Transistors with dual work function metal gates by Single Full Silicidation(FUS I) of polysilicon gates : Electron Devices Meeting, 2002. IEDM '02. Digest. IEEE International (2002) (米) p. 367-370	1-31
A	Kedzierski et. al. Threshold voltage control in NiSi-gated MOSFETs through silicidation induced impurity segregation (SIIS) : Electron Devices Meeting, 2003. IEDM '03 Technical Digest. IEEE International (2003) (米) p. 315-318	1-31
T	Tera i et. al. Highly Reliable HfSiON CMOSFET with Phase Controlled NiSi (NFET) and Ni ₃ Si (PFET) FUSI Gate Electrode : 2005 Symposium on VLSI Technology Digest of Technical Papers (2005) (米) p. 68-69	1-31
P X	Takahashi et. al. Dual work function Ni-Silicide /HfSiON gate stacks by Phase-Controlled full-silicidation (PC-FUSI) Technique for 45nm-node LSTP and LOP Devices : Electron Devices Meeting, 2004. IEDM Technical Digest. IEEE International (2004) (米) p. 91-94	1-31